

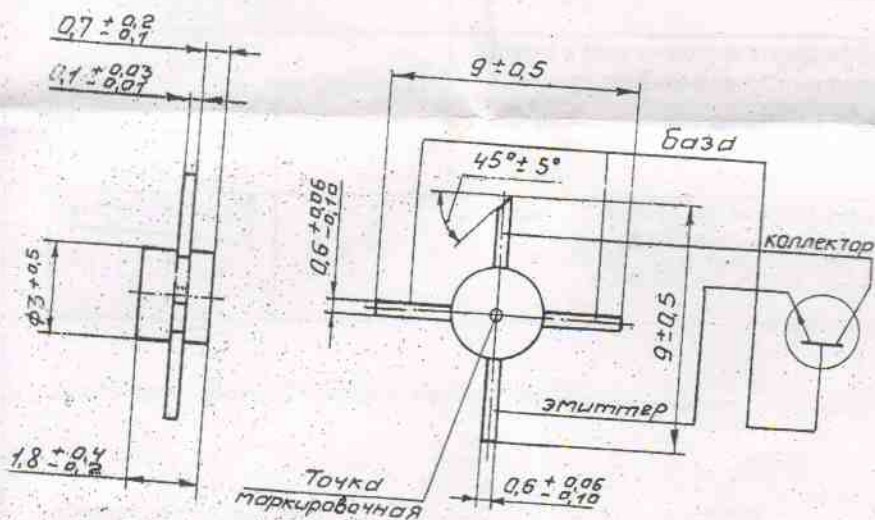


п 31612 в коробке
Транзистор типа 2Т643А-2

Дата изготовления _____
(год, месяц)

ЭТИКЕТКА

Кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор типа 2Т643А-2, предназначенный для применения в схеме с общей базой в усилительных и генераторных устройствах в диапазоне частот от 2 до 8 ГГц в составе гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры.



Масса не более 0,2 г.

Тип транзистора	Точка маркировочная
2Т643А-2	синяя

Основные электрические параметры при $t_{кр} = (25 \pm 10) ^\circ C$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мА, $U_{кб} = 25 \text{ В}, I_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ C$	$I_{кбо}$	-	1,0
Обратный ток эмиттера, мА, $U_{эб} = 3 \text{ В}, I_{окр} = (25 \pm 10) ^\circ C$	$I_{эбо}$	-	0,1
Выходная мощность (медианное значение), мВт, $U_{кб} = 15 \text{ В}, I_{к} = 90 \text{ мА}, f = 7 \text{ ГГц},$ $P_{вх} = 200 \text{ мВт}$	$P_{вых \text{ Me}}$	500	-
Фаза коэффициента передачи тока в схеме с общей базой на высокой частоте, градус, $U_{кб} = 5 \text{ В}, f = 1 \text{ ГГц},$ $I_{к} = 130 \text{ мА}$	$\sigma_{тq}(h_{21\beta})$	*	25
Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой, $U_{кб} = 5 \text{ В}, I_{к} = 50 \text{ мА}, f = 100 \text{ МГц}$	$ S_{12} $	-	$1,5 \cdot 10^{-3}$

Содержание драгоценных металлов

Наименование драгоценного металла	В 1000 шт. транзисторов, г	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода, г/мм	Толщина покрытия, мкм
золото	8,12	0,0001	5
серебро	1,05	-	-

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзистор 2Т643А-2 соответствует техническим условиям аАО.339.138 ТУ.

Принят по извещению № 30 от 2018.11 дата

Место для штампа ОТК

Место для штампа военного представительства

Место для штампа «Перепроверка произведена _____» дата

Принят по извещению № _____ от _____ дата

Место для штампа ОТК Место для штампа военного представительства